



奈米中心低壓化學氣相沉積系統(LPCVD)考核記錄表

學校系所：_____ 姓名：_____ 學號：_____ 考核日期：_____

一. 筆試：填空題 25%

1. 不可進入爐管之材料，請說明_____。(5%)
2. LPCVD 容許最高溫度_____°C，升溫速率設定_____°C/分。(5%)
3. LPCVD 製程區分_____種，分別使用氣體為_____。(10%)
4. 爐管程式設定共_____組，每組共_____步驟。(5%)

二. 實作：75%

5. 操作前檢查：水、電、氣、泵浦、洗滌塔是否正常運轉，操作記錄簿填寫及操作標示牌等事項。(10%)
6. 晶片準備(含晶片清洗)、晶舟取用、晶片放置等前置作業。(10%)
7. 各項操作步驟(50%)
 - A. A~D 爐製程選定。
 - B. 人機介面功能解說。
 - C. 製程參數選定及說明。
 - D. 溫度、壓力、氣體流量曲線及製程資料查詢
 - E. 實驗結束後復歸動作。
8. 異常及狀況處置。(5%)

備註：(1)考核及格分數為80分。

(2)通過考核者請持學生證至機台管理者處登錄開卡後方得自行操作。

考試時間： : ~ : 評分_____ 考核員簽名：_____